



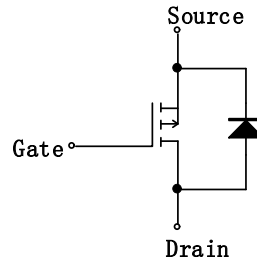
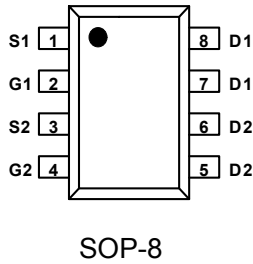
TC4953 (文件编号: S&CIC0750)

20V P 沟道增强型 MOS 场效应管

VDS= -20V

RDS(ON), Vgs@-4.5V, Ids@-3A = 62mΩ@TYP

RDS(ON), Vgs@-2.5V, Ids@-2.5A = 88mΩ@TYP



P-Channel MOSFET

特点

- 先进的沟道工艺技术
- 高密度超低电阻设计
- 改良的成形工艺

最大额定值和热特性(TA = 25℃, 除非另有说明)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V _{DS}	-20	V
栅源电压	V _{GS}	±12	
漏极电流	I _D	-3	A
漏极脉冲电流	I _{DM}	-1	
工作结温和存储温度范围	T _J , T _{stg}	-50 to 150	℃

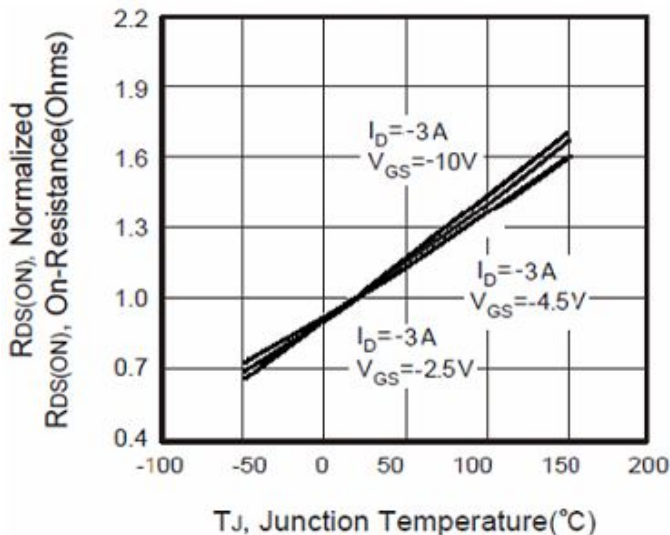
注：重复性极限值：脉冲宽度由最高结温限制。



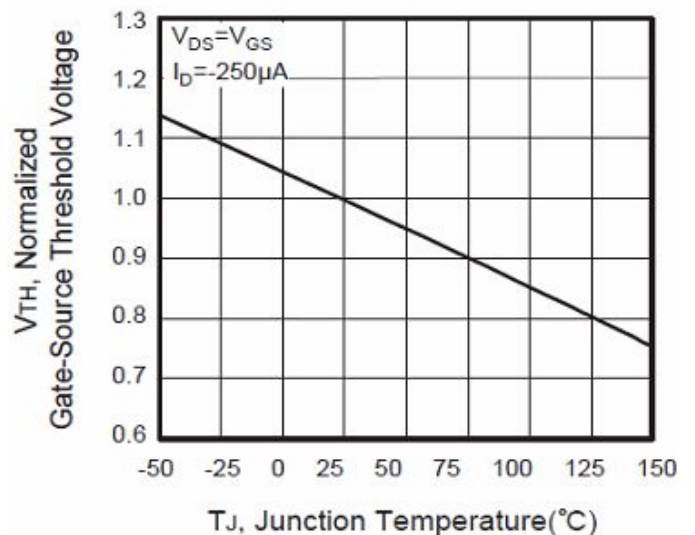
电特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静电						
漏源击穿电压	B_{VDSS}	$V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$	-20	--	-23	V
漏源电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -4.5V, I_D = -3A$	--	62.0	90.0	mΩ
	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -2.5V, I_D = -3A$	--	88.0	120.0	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$	-0.4	-0.7	-1	V
漏极到源极的漏电流	I_{DSS}	$V_{DS} = -20V, V_{GS} = 0V, T_J = 25^\circ C$	--	--	1	uA
栅极到源极的漏电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 12V$	--	--	±100	uA
漏极持续电流	I_D				-3	A

温度 VS $R_{DS(on)}$ / $V_{GS(th)}$



$R_{DS(on)}$ VS 结温



$V_{GS(th)}$ VS 结温

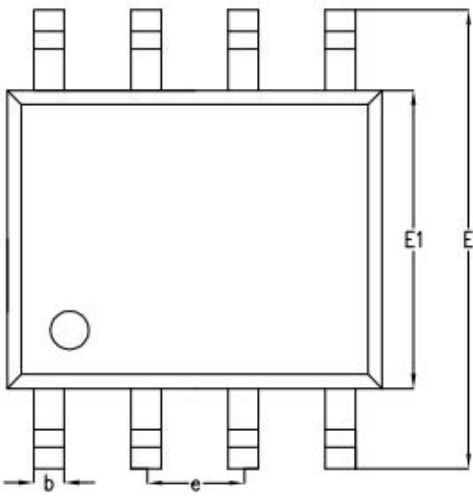
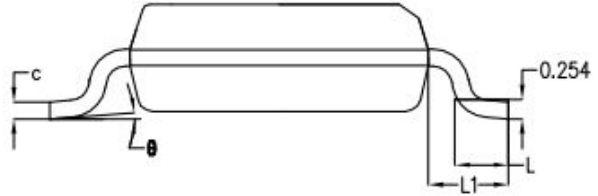
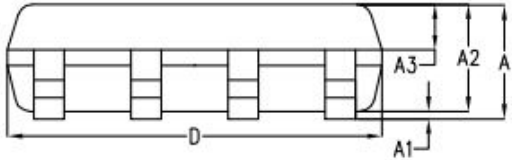


TC4953 (文件编号: S&CIC0750)

20V P 沟道增强型 MOS 场效应管

封装信息

SOP-8



符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	-	1.50	1.55
A1	-	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	4.85	4.90	4.95
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°